

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁴
C25D 11/00

(11) 공개번호 특1987-0001334
(43) 공개일자 1987년03월13일

(21) 출원번호	특1986-0003307
(22) 출원일자	1986년04월29일
(30) 우선권주장	161566 1985년07월22일 일본(JP)
(71) 출원인	미쓰비시덴기 가부시기가이샤 시기 모리야 일본국 도오교도 지요다구 마루노오퍼 2-2-3스즈기 마사히고 일본국 나고야시 텐바구구 야고도이시자가 660-33 모리 나오다게 일본국 나고야시 텐바구구 텐바구초 시마다 구로이시 3837-3 스즈기 마사히고 일본국 나고야시 텐바구구 고도이시사가 660-33 사이도 나가오 일본국 도오교도 지요다구 마루노오퍼 2-2-3 미쓰비시덴기 가부시기가이샤 내 모리 나오다게 일본국 나고야시 텐바구구 텐바구초 시마다 구로이시 3837-3 다가하시 히테아기 일본국 센다이시 곤고자와 1-30-11 쇼우지 테즈오 일본국 센다이시 야미테초 21-3
(72) 발명자	
(74) 대리인	백남기

심사청구 : 있음

(54) 반금속의 전극을 사용한 방전 가공에 의한 표면층의 형성방법

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

반금속의 전극을 사용한 방전 가공에 의한 표면층의 형성방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 실시예 1에 의한 시험 결과를 도시한 애노드 분극 곡선도.

제2도는 그 에너지 분산법에 의한 선분석도.

제3도는 실리콘 전극으로 방전 가공한 불수강(SUS304)의 금속 조직의 현미경 사진으로서,

(a)는 SEM상에서의 금속 조직의 현미경 사진,

(b)는 EMPA에 의한 선분석에서의 금속 조직의 현미경 사진.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

방전 가공의 전극으로서 반금속을 사용하여, 액체중 또는 가스중에 있어서 방전 가공을 행하고, 피가공물 표면에 어몰퍼스 합금층 혹은 미세한 결정 구조를 가진 표면층을 형성하는 것을 특징으로 하는 반금속의 전극을 사용한 방전 가공에 의한 표면층의 형성방법.

청구항 2

반금속은, 실리콘 또는 티타늄 카바이드인 것을 특징으로 하는 특허청구의 범위 제1항 기재의 반도체의 전극을 사용한 방전 가공에 의한 표면층의 형성방법.

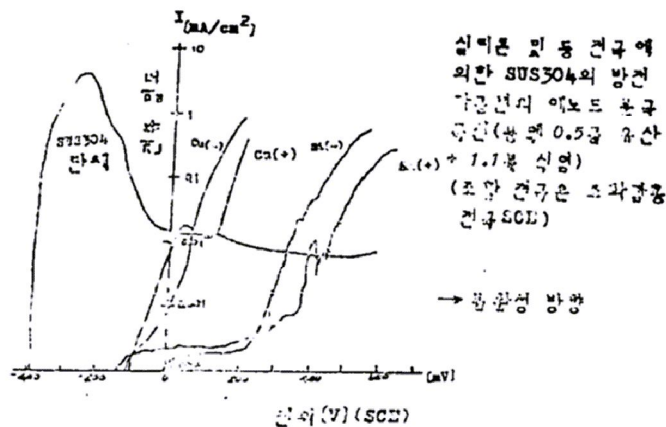
청구항 3

피가공물은, 합금강, 합금 또는 순금속인 것을 특징으로 하는 특허청구의 범위 제1항 또는 제2항 기재의 반금속의 전극을 사용한 방전 가공에 의한 표면층의 형성방법.

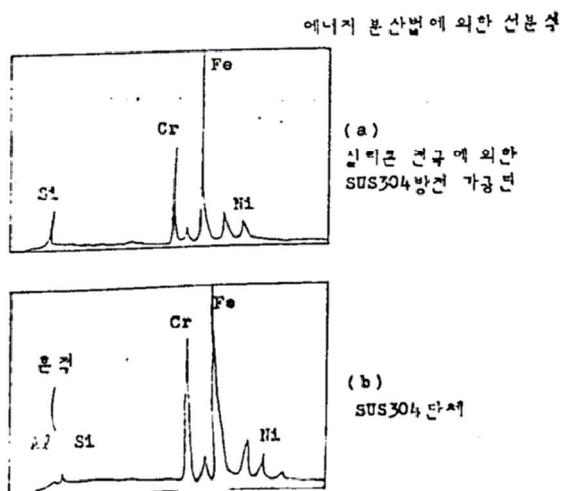
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

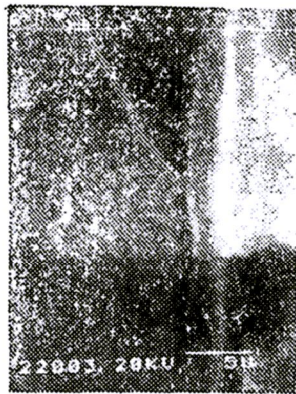
도면1



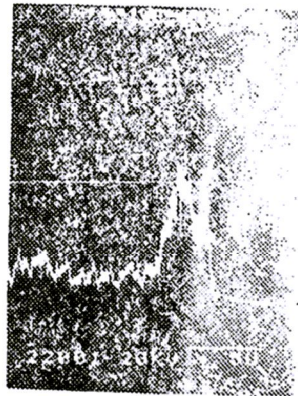
도면2



도면3



표면층 두께(약 3μm)



표면층 두께

[원부과 동일한 사진이 EDMA에 의한 선분식 그림으로 중첩한 것]

(a) SEM상
(전자 현미경에 의한)
촬영 관찰

(b) EDMA에 의한 선분식
(선분식 측정 구간은 표면
층(3μm)의 위치여 있거
서 심미관의 표층이
나오고 있다.)

심미관 전극에 의한 SUS304의 방전 가공면의 단면상